

スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 単価表

2020年4月1日設定

※ 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当すると判断される場合には、**50%の減額措置**を行います。
 ※ 処理の内容によっては、単価表に記載された金額よりも高くなる場合もあります。
 ※ 研究支援施設であるため、大量の試作については受け入れが難しい場合がございます。
 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

● プロセス装置 ・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2
				標準レンピを使用する場合 (円/枚)	チューニングが必要な場合 (円/時間)	同一の標準レンピを使用する場合(~25枚) (円/FOUP)	
露光装置	1	L01-104 L01-103	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+) ArF液浸露光装置 (NSR-S610C) ※注3	80,000	240,000	1,000,000	10,000
	2	M01-08 M01-10	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) KrF露光装置 (FPA-5000ES3) ※注3 ※注4	32,000	180,000	400,000	10,000
	3	U01-102 U01-101	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) i線アライメント付i線露光装置 (FPA-5510iZs) ※注3	32,000	180,000	400,000	10,000
	4	AH08-107	EUVフレーム露光装置 (EUVES-7000GC)		40,000		10,000
塗布現像装置	5	L01-104c	ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+)	36,000	180,000	450,000	10,000
	6	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4				
	7	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)	24,000	120,000	300,000	10,000
	8	M01-04	レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)				
成膜装置	9	I03-101	マニュアル有機現像装置 (Litho Spin Cup 300D)		120,000		10,000
	10	B03-07	プラズマCVD装置 (Eagle-12) ※注4				
	11	M03-06	プラズマCVD装置 (Eagle-12 Rapidfire) ※注4				
	12	B03-06	プラズマCVD装置 (VECTOR) ※注4				
	13	F03-103	プラズマCVD装置 (VECTOR)				
	14	M03-01	高密度プラズマCVD装置 (Concept 3 Speed)				
	15	P03-101	高密度プラズマCVD装置 (MAPLE) ※注4	28,000	168,000	350,000	10,000
	16	M03-14	High-k ALD装置 (Trias-ALD)				
	17	M06-04	メタルCVD装置 (Trias-W)				
	18	F03-07	窒化膜LP-CVD装置 (TELFORMULA) ※注4				
	19	M03-03	酸化膜LP-CVD (TEOS)装置 (TELFORMULA) ※注4				
	20	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置 (DJ1226V-DF)				
	21	U03-101B	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT Staircase)				
	22	B06-101	バリアシードスパッタ装置 (Endura2 EnCoReII Ta/Cu) ※注4	40,000	120,000	500,000	10,000
	23	F06-101	新材料スパッタ装置 (Iarim C-7100GT) ※注4				
	24	M06-03	メタルスパッタ装置 (GOSMOS I-1201)	25,000	120,000	312,500	10,000
	25	M06-07	メタルスパッタ装置 (ENTRON W-300) ※注4				
	26	B06-102	Cuめっき装置 (SABRE NExt)	50,000	140,000	625,000	10,000
	27	P03-105	Geエピ装置 (FC7200)	56,000	112,000		10,000
	28	AP03-101	SiGe/Ge成膜装置 (Epsilon)	56,000	112,000		10,000
エッチング装置	29	M02-04	Poly-Siエッチング装置 (Centura DPSII/axiom) ※注4	65,000	180,000	812,500	10,000
	30	M02-05	メタルエッチング装置 (Centura DPSII/ASPII) ※注4				
	31	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置 (Centura Enabler/DPS232) ※注4	40,000	180,000	500,000	10,000
	32	M02-01	酸化膜エッチング装置 (Telius SCCM-Ox/DRM-Ox) ※注4				
	33	M02-10	酸化膜エッチング装置 (Telius DRM-Ox/SCCM-Poly) ※注4	20,000	120,000	250,000	10,000
	34	B02-01	Low-kエッチング装置 (Telius SCCM-Ox) ※注4				
	35	F02-101	新材料エッチング装置 (U-8150) ※注4				
アッシング装置	36	B02-03	アッシング装置 (ICE300/RPA300) ※注4				
	37	M02-07	アッシング装置 (μASH300) ※注4	14,000	150,000	175,000	10,000
イオン注入装置	38	P02-105	アッシング装置 (ICE300/μASH300) ※注4				
	39	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置 (EXCEED2300V) ※注4	69,000	196,000	862,500	10,000
熱処理装置	40	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置 (SHX) ※注4				
	41	M03-101	RTA/RTP装置 (Radiance) ※注4	75,000	180,000	937,500	10,000
	42	M04-02	ゲート酸化RTA/RTP装置 (Trias SPA300)	85,000	204,000	1,062,500	10,000
	43	B04-01	縦型アニール装置 (VF-5700B) ※注4				
洗浄装置	44	M04-101	縦型酸化炉 (ALPHA-303i-K) ※注4	20,000	160,000	250,000	10,000
	45	M07-15	バッチ式洗浄装置 (UW300Z) ※注4				
	46	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置 (VENUS) ※注4				
	47	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置 (SFAW-1201-008) ※注4	18,000	100,000	225,000	10,000
	48	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置 (ZETA300 BE) ※注4				
	49	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット (DGP8761SC)				
	50	M07-02	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN MP-3000) ※注4				
	51	M07-101	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4				
	52	M07-102	枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4				
	53	P07-105	枚葉式洗浄装置 (KC-A300CBT)	7,500	80,000	93,750	10,000
CMP装置	54	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置 (SEZ323) ※注4				
	55	P07-103	小口径対応枚葉式洗浄装置 (SRWC-12801-8P-2C)				
	56	M07-09	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4	4,800	40,000	60,000	10,000
	57	M07-12	スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4				
3D実装装置 (中間工程)	58	N07-101	STI、W CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M)				
	59	B07-101	Cu CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M)	57,000	176,000	712,500	10,000
	60	P07-101	CMP装置 (F-REX300E)				
	61	B02-101D	Si深掘りエッチング装置 (Centura Silvia)	65,000	260,000	812,500	10,000
	62	U03-101A	プラズマCVD装置 (PRODUCER GT InViaII)	56,000	260,000	700,000	10,000
	63	U06-101	Cuめっき装置 (NEXX Cu ECD)	100,000	260,000	1,250,000	10,000
	64	U07-101	Oxide CMP装置 (Reflection LK Oxide)	114,000	260,000	1,425,000	10,000
65	U12-102	ウェハ接合装置 (WS3000)		260,000		10,000	
66	U07-102	ウェハエッジトリミング装置 (DFD6860)	57,000	260,000	712,500	10,000	
67	U07-103	Si裏面研削研磨装置 (DGP8761SC)	114,000	260,000	1,425,000	10,000	

注1~4については2ページ末尾をご参照ください。

● プロセス装置

・スーパークリーンルーム外

その他	68	AF03-16	真空蒸着装置 (VX-30-S)	35,000	112,500		10,000
	69	M04-08	評価用小片アニール装置 (VHC-P616CP-S)		74,000		10,000

● 分析装置

・スーパークリーンルーム

装置区分	No.	装置番号 ※注1	施設等名称	共用施設等使用料			技術指導費等 ※注2
				標準レシピを使用する場合	チューニングが必要な場合	同一の標準レシピを使用する場合 (~25枚)	
				(円/枚)	(円/時間)	(円/FOUP)	
重ね合わせ精度測定	70	M08-55	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)				10,000
	71	P08-116	重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)		114,000		
薄膜解析	72	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置 (ASET-F5)				10,000
	73	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置 (ASET-F5X)				
	74	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置 (μ SE-2500-A)			28,000	
	75	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置 (M-2000X)				
	76	AF08-12	単色エリプソ膜厚測定装置 (MARY-102SM)				
	77	P08-104	反射分光膜厚測定装置 (F50-EXR)				
	78	B08-04	蛍光X線膜厚測定装置 (PW2820)		40,000		
	79	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置 (System 3272E)				
	80	F08-04	X線回折装置 (TTR In-plane XRD)		56,000		
反り・応力測定	81	B12-101	反り/膜応力自動測定装置 (I28LC2C)				10,000
	82	M08-12	反り/膜応力測定装置 (I28L)		24,000		
パーティクル検査	83	P08-105	パーティクル検査装置 (WM-10)				10,000
	84	P08-106	パーティクル検査装置 (WM-10)		56,000		
金属汚染検査	85	P08-107	全反射蛍光X線分析装置 (TXRF 310Fab) ※注5				10,000
	86	AF08-18	全反射蛍光X線分析装置 (TXRF 300) ※注5				
	87	P08-109	自動濃縮装置 (Expert)		40,000		
	87	P08-113	ICP-MS質量分析装置 (NexION 2000) ※注3 ※注5				
抵抗測定	88	M08-10	シート抵抗測定装置 (RS-100)				10,000
	89	M08-25	シート抵抗測定装置 (VR-120/08)				
	90	M08-32	シート抵抗測定装置 (VR-120/08S)		12,000		
	91	P08-102	シート抵抗測定装置 (VR300DSE)				
SEM観察	92	I08-110	測長SEM装置 (CG5000)				10,000
	93	L08-103	測長SEM装置 (CG4000)		30,000		
	94	P08-101	測長SEM装置 (S-9380 II)			24,000	
	95	P08-103	測長SEM装置 (S-9380 II)				
光学顕微鏡	96	P08-115	レビューSEM (SEMVision G6)		108,000		10,000
	97	M08-40	光学顕微鏡 (AL3110F)				
	98	M08-50	光学顕微鏡 (AL3110F)			4,000	
	99	M12-101	光学顕微鏡 (AL110)				
	100	M12-102	光学顕微鏡 (AL120)				

・スーパークリーンルーム外

高分解能観察	101	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡 (ORION Plus)		32,000		10,000
FIB加工/STEM	102	B08-02-01	FIB装置 (FB2100) ※注5		18,000		10,000
	103	AF08-402	走査透過電子顕微鏡 (HD-2700) ※注5				
	104	B08-02	走査透過電子顕微鏡 (HD-2000) ※注5		24,000		10,000
断面SEM	105	J03-117	走査電子顕微鏡 (S-4700) ※注5				10,000
	106	M08-04	走査電子顕微鏡 (S-5000) ※注5				
	107	B08-12	走査電子顕微鏡 (S-5200) ※注5		10,000		
分析	108	AF08-14	X線光電子分光分析装置 (ESCA-1800)		40,000		10,000
	109	B10-06	IR-OBIRCH解析装置 (μ AMOS)		40,000		10,000
	110	J03-116	昇温脱離ガス分析装置 (WA1000S/W)		38,000		10,000
	111	J03-114	赤外分光分析装置 (Excalibur FTS-3000)		44,000		10,000
電気特性評価	112	J03-118	フルオートプローバ (P-12XL) テスター (4073B/N9201A)				10,000
	113	M08-42 M10-01	フルオートプローバ (P-12XL) テスター (4073A) ※注3		38,000		
	114	M10-05	フルオートプローバ (P-12XL) テスター (4076)				
	115	F10-01	セミオートプローバ (S300-861) テスター (4156C/4284A/4294A)				
	116	M10-04 M08-47	セミオートプローバ (S300-561) テスター (4156C/4284A/4294A) ※注3		30,000		
	117	B10-04 B10-05	マニュアルプローバ (Model 9920A) テスター (4156B/4284A) ※注3				
	118	J03-115	水銀プローバ (SSM 5130)		38,000		
シミュレータ	119	SIM-01	露光シミュレータ (PROLITH) ※注5		40,000		10,000

注1 装置番号は、SCRで装置管理のために使用している番号です。

注2 技術指導費等は、装置使用方法の指導、あるいは特別な作業依頼の場合に、利用者と協議の上で適用いたします。

注3 これらの装置はセットでのご利用となります。

注4 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当し、かつ、操作方法習得済の利用者自身による夜間流動の場合、FOUP単位料金の50%減額を行います。

注5 プロセス装置をご利用になられる方のみ利用提供している装置です。

※この単価表に基づく料金に、運営管理費(15%)と消費税が加算されます。(共用施設等利用約款別表第2)

※来所して装置をご利用いただく場合は、利用者に係る人頭経費を徴収させていただきます。(連携研究等経費算定要領別表第3)

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理いたします。